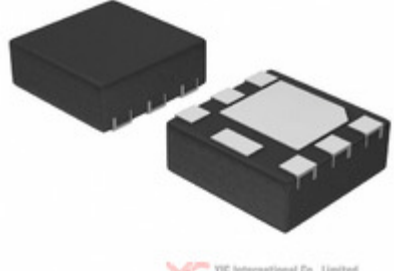

	<h2 style="color: red;">NTLJS3113PT1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTLJS3113PT1G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN
Datenblätter:	 NTLJS3113PT1G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 244710 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	NTLJS3113PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	244710 pcs Stock
Serie	μCool™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250μA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1329pF @ 16V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTLJS3113PT1G ist neu im Original, Suche NTLJS3113PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTLJS3113PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTLJS3113PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 NTLJS3180PZTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN	 NTLJS2103PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 3.5A 6-WDFN	 NTLJS3180PZTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN	 NTLJS2103P ON NTLJS2103P ON
 NTLJS3A18PZTXG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.4A WDFN6	 NTLJS2103PTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 3.5A 6-WDFN	 NTLJS3113PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN	 NTLJS3113P ON NTLJS3113P ON

heiße Teile

Mehr

⊕ 08052A111GAT2A	↔ 2MBI150PC-140	⇒ BZD17C150P-E3-08	D C1608JB1A335K080AB	⇒ C2012C-R15J
⊖ CL21B474KAFNNNE	⊕ HZM6.2ZMFATL-E	D IDT71321SA55PFI	⇒ LDC5-12D5	⇒ LT1217CS8#TRPBF
⊕ MAX6719UTSFD3	⊖ MCP41010T-I/SN	⊕ NTLGD3502NT1G	↔ NTLGD3502NT2G	⇒ NTLJ3113PT1G
D NTLJD2105LTBG	⊕ NTLJD3115PT1G	⊖ NTLJD3115PTAG	⊕ NTLJD3119CT1G	⇒ NTLJD3119CTAG
⇒ NTLJD3119CTBG	↔ NTLJD4116NT1G	⊕ NTLJF3117PT1G	⊖ NTLJF4156NT1G	⇒ NTLJF4156NTAG
↔ NTLJS2103P	⇒ NTLJS2103PTAG	D NTLJS2103PTBG	⊕ NTLJS3113P	⊖ NTLJS3113PTAG
⊕ NTLJS3A18PZTWG	D NTLJS4114NT1G	⇒ NTLJS4114NTAG	↔ NTLLED4901NF	⇒ NTLLED4901NFTWG
⊖ NTLTD7900NR2G	⊕ NTLTD7900ZR2	↔ NTLTD7900ZR2G	⇒ NTLUD3A260PZTAG	⇒ NTLUD3A50PZTAG
⊕ NTLUF4189NZTAG	⊖ NTLUS3A18PZTAG	⊕ NTLUS3A40PZTAG	D NTLUS3A40PZTBG	⇒ NTLUS3A90PZTAG
↔ NTLUS4930NTAG	⊕ OPA349NA/3KG4	⊖ ST650C24L	⊕ UPD161644	⇒ V300C3V3T75A2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited